SuperKEKB 陽電子ダンピングリングの真空制御システム

VACUUM CONTROL SYSTEM OF POSITRON DAMPING RING FOR SUPERKEKB

照井真司^{#, A)}, 石橋拓弥^{A)}, 柴田恭^{A)}, 末次祐介^{A)}, 白井満^{A)}, 金澤健一^{A)}, 久松広美^{A)}, 芳藤直樹^{B)}, 中村達郎^{A)}, 小田切淳一^{A)}

Shinji Terui^{#, A)}, Takuya Ishibashi ^{A)}, Kyo Shibata ^{A)}, Yusuke Suetsugu ^{A)}, Mitsuru Shirai ^{A)}, Ken-ichi Kanazawa ^{A)},

Hiromi Hisamatsu ^{A)}, Naoki Yoshifuji ^{B)}, Tatsuro Nakamura ^{A)}, Jun-ichi Odagiri ^{A)}

^{A)} High Energy Accelerator Research Organization (KEK)

^{B)} East Japan Institute of Technology Co., Ltd.

Abstract

The vacuum system of the positron damping ring (DR) for SuperKEKB is now under construction. The aluminum-alloy beam ducts have antechambers on both sides of a beam channel, but the aperture is limited by the small bore-sizes of magnets. The main pumps are cartridge-type non-evaporable getters (NEG) and ion pumps, of which locations are optimized for evacuating the small-conductance beam duct. The target pressure is less than 1×10^{-5} Pa at a nominal beam current. For the vacuum control system, the F3RP61 CPU of FA-M3 Programmable Logic Controller (PLC) are used as an Input Output Controller (IOC) running on the Experimental Physics and Industrial Control System (EPICS). After a preliminary test using the two cells of beam ducts in the laboratory, the interlock logic and the NEG-activation program was tested at the DR arc sections and successfully functioned. The control system will be completed by this fall, 2017.

1. はじめに

SuperKEKBはKEKBBファクトリー(KEKB)の後継機 となる高ルミノシティの電子・陽電子衝突型加速器であり、 2016年2月から6月にかけて試運転が行われた[1]。 SuperKEKBプロジェクトの目的は、ルミノシティをKEKB での達成値の約40倍(8×10³⁵ cm²s⁻¹)に上げ、標準理論 を越えた新しい物理を探索することである。この高いルミ ノシティを実現するために、SuperKEKBではナノ・ビーム 方式[2,3]と呼ばれる衝突方式が採用された。この方式 では、衝突点でのビームサイズを垂直方向:60 nm、水平 方向:10 µm まで絞り込む必要があり、力学口径とビーム 寿命の減少は避けらない。そのため、入射ビームとしても 低エミッタンスかつ強度の高いビームを供給する必要が ある。陽電子ビームに関しては、入射ビームのエミッタン スを下げるためにダンピングリング(DR)[4]が入射器の

Table	1:	Parameters	of	DR
-------	----	------------	----	----

Beam energy	1.1	GeV	
Bunch number	4		
Circumference	135.5	m	
Maximum stored beam current	70.8	mA	
Maximum bunch charge	8	nC	
Bunch length	6.53	mm	
Bending radius	2632/2967	mm	
Critical energy	0.93/0.82	keV	
Total SR* power	7.2	kW	

*Synchrotron Radiation

sterui@mail.kek.jp

途中に新設される。DR の主なパラメーターを Table 1 に 示す。DR はレーストラック形の蓄積リングで、ビームエネ ルギーは 1.1 GeV、最大蓄積電流は約 70 mA、バンチ数 は 4、バンチ長は約 7 mm である。アーク部で使用される 主な偏向電磁石は曲率半径 2632 mm と 2967 mm であ り、放射光の臨界エネルギーはそれぞれ 0.93 keV と 0.82 keV、リングー周あたりの放射光のパワーは 7.2 kW であ る。

SuperKEKB では現在 2017 年度末から予定されてい る本格的な物理実験を行うための改造作業が行われて おり、DR 建設もその一環である。DR の運転開始は、 2017 年冬が予定されているため DR の真空システムの 建設は、2017 年冬に終わらせる。ここでは、DR 真空シス テム、特にその制御システムの構成、準備状況と、ビー ムダクト排気試験の結果等を報告する。

2. 真空システムの概要

DR の全体構成を Fig. 1 に示す。DR は 2 つのアーク 部(約 110 m)と2 つの直線部(約 20 m)からなっており、



Figure 1: Overall view of DR.



Figure 2: Beam ducts for the arc sections.



Figure 3: Layout of the DR beam ducts in one cell of the reverse-bend FODO lattice[4].

ビームダクトはゲート弁 (GV)で5つの領域に分割される。 アーク部のビームダクトは、タイプの異なる偏向電磁石毎 に2種類(Type Iと Type II)あり、それぞれのビームダク トは、各一台ずつの偏向電磁石、四極電磁石、六極電 磁石内に設置される。各タイプのアーク部用ビームダクト をFig. 2 に、1 セル分のレイアウトを Fig. 3 にそれぞれ示 す[5]。2セルで6つのポンピングポートがあり、そのうちの 1つのポンピングポートに、イオンポンプ [45 ℓ/sec]と L 型弁が取り付けられている。L型弁には、粗排気(ターボ ポンプとスクロールポンプ)セットが取り付け可能になって いる。粗排気は、加速器運転中には取り外す。その他の 5つのポンピングポートにはカートリッジ型の NEG ポンプ C50-ST707が取り付けられている。排気はこの NEG ポン プとイオンポンプによって行われ、加速器運転中の平均 到達圧力の目標値は 1×10⁻⁵ Pa 以下である。

3. 真空制御システムの構成

制御すべき真空機器は、GV、真空スイッチ(VSW)、 イオンポンプ電源、NEG ポンプ活性化電源、CCG、温 度計、冷却水流量計、残留ガス分析計、ターボポンプ等 である。

SuperKEKB 全体が EPICS [6]をベースにした制御シ ステムを構築しているので、真空制御でも EPICS を用い たシステム設計を行った。Operator Interface (OPI) と IOC、IOC と IOC の間の通信には、EPICS の通信プロ トコル Channel Access (CA)を使用している。DR 真空制 御システムの構成を Fig. 4 に示す。SuperKEKB のメイ ン・リングと同様に[7,8]、IOC として、横河電機社製の FA-M3 PLC の CPU モジュールである F3RP61 を採用 した[9]。F3RP61 は OS として Linux を採用している ため、簡単なデバイス/ドライバサポートを作成するだけ で IOC として利用可能である。各種真空制御アプリ ケーションはこの IOC 上で実行している。また F3RP61 は従来型のシーケンス CPU とマルチ CPU 構成を採 ることが可能であり、その場合、両者はベース・モジュー ル(バックレーン)を介して通信する。本真空制御システム でのインターロック・ロジックについてはシーケンス CPU 上で堅牢性が高いラダープログラムで実装されている。

Figure 5 に、DR の制御室ラックに設置した PLC の写 真を示す。インターロック・ロジックでは、イオンポンプ電 源と NEG ポンプ活性化電源と Cold cathode gauge (CCG)電源の印加許可、GV 開閉等を行っている。

アナログ信号については、粗排気セットからのチャネ ル数が多いため、高密度の入出力モジュールが必要と なる。このため 32 チャネル/モジュールの Analog to Digital Converter (ADC)を持つ National Instruments 社の CompactRIO (cRIO)を採用した。cRIO には Channel Access Server と呼ばれる機能があり、 Device/Driver Support を作成することなく Channel Access Client (IOC 側)との通信が可能となる。

DRでは、ほとんど真空計を用いず、イオンポンプの放 電電流から真空値を計算する。この電源では 1×10⁻⁷ Pa 程度までの低い圧力を測定可能であることが求められる (放電電流の測定精度は 10 nA)。イオンポンプ電源は、 上の条件を満たす Gamma 社製の QPCe を採用した。こ の電源は、1台で最大 4 チャネルを制御できるので、ラッ ク内のスペースが節約できることと、シャーシの数を少な くできるため費用が抑えられることがメリットである。QPCe の外部との通信インターフェースは RS232C が安定で あったため、制御用のネットワークから MOXA 社のイー サネット・シリアル変換機 NPort5610-16 を介して FA-M3 コントローラと接続した。

DR 真空制御システムのユーザインターフェースについては、Control System Studio (CSS)を使用して開発を行った。Figure 6 に、DR での OPI の一部を示す。



Figure 4: Configuration of DR vacuum control system.



Figure 5: PLC of DR vacuum control system.



Figure 6: Control panel for various vacuum components of DR.

4. 排気試験

4.1 DR での NEG ポンプ活性化時のインターロック

DRではマグネットのボア半径の狭さから、ビームダクト のコンダクタンスが小さくなっている。また、スペースの問 題等から、カートリッジ型 NEG ポンプ C50-ST707 を使用 している。コンダクタンスが小さいので、NEG ポンプ活性 化中、NEG ポンプ付近の圧力が高くならないように制御 しつつ、放出されるガスを粗排気装置で排気するために は、活性化時間を長くせざるを得ない。実際、活性化時 間は、5 日間以上にも及ぶ。そのため、NEG ポンプ活性 化電源は、シーケンス制御を行い、ガスが短時間で大量 に出てこないようにしている。また、ガス放出量が想定以 上となり圧力が閾値より悪化した場合は、ガス放出量の 増加を抑えるため、その時点での電圧出力状態を自動 的に維持するポーズ機能も実装している。これに併せて、 ターボポンプの情報も監視しておき、エラー情報が来た 場合は、NEG ヒータ活性化電源の出力を止める機能も 実装している。Figure 7 に、インターロック・ロジックダイア グラムを示す。



Figure 7: Interlock logic diagram for NEG activation.

4.2 2 セルでの排気試験

NEG ポンプ活性化時のシーケンスパターンの確立や 活性化時の NEG ポンプがついているポンピングポート の温度の確認等のために、実験室で2セルでの排気試 験を行った。Figure8に、2セルでの排気試験のシステム 図と実験時の写真を示す。Figure 9 に、最初に NEG ポ ンプ活性化を行った時の圧力の時間変化を示す。青線 は、ビームチャネル部の圧力である。緑線は、ポンピング ポートの温度である。最初の試験時、高い圧力で活性化 した結果、Fig. 10 に示すように NEG ポンプが変色した。 この原因は、NEG ポンプ位置ではなく、粗排気装置近く のビームチャネル部の圧力値を基準に活性化をしたこと にある。Figure 9 中の赤丸の場所で、ポンピングポート内 の圧力が NEG ポンプの許容圧力範囲である 1×10⁻¹ Pa を超えてしまったと推測している。Figure 11 に示す圧力 モニターチェンバーを用いて圧力を測定したところ、 NEG ポンプ活性化中には、NEG ポンプから出てくるガス により、TMP 上流の圧力よりも、ポンピングポートの圧力 は 20~30 倍になることがわかった。この結果から、ポン ピングポートの圧力が 1×10-3 Pa を超えないように電源を 制御するように、4.1節で述べた自動的にポーズがされる 機能を加えた。この試験により、NEG ポンプ活性化電源 出力パターンを確立した。活性化時のポンピングポート の温度が近接しているマグネットのコア部に影響を及ぼ さないことも確認した。また、ビームチャネル部の圧力とイ オンポンプで測っている圧力の差を測定できたので、運 転中のビームチャネル部の圧力を精度よく予測すること が可能になった。



Figure 8: System layout and photograph of the pumping test using 2 cells of the DR beam ducts.



Figure 9: Pattern of NEG activation sequence when the NEG elements were damaged.



Figure 10: Discoloration of NEG pump after activation under high pressure.



Figure 11: Special chamber measuring the pressure at NEG pumping port.

5. 真空立ち上げ試験

2017 年初めから、西アーク部で真空立ち上げ試験を 行った。真空立ち上げ試験時には、一部ビームパイプが まだつながっていない状態で行われた。このためイオン ポンプは、ビーム運転時には11台ある予定であるが、試 験時は9台で行っている。立ち上げには、十分に時間を かけて粗排気装置で圧力を低くした後に、1週間位かけ て NEG ポンプのガス出しを行い、1週間以上かけて NEG ポンプ活性化を終えた。ガス出しとは、活性化に先 立ち、NEG ポンプの表面についているガスを活性化温 度以下で温めて放出させることである。ガス出しをするこ とで、活性化時に NEG ポンプ自身から出てくるガスが減 り、よりポンプの性能を生かすことができる。Figure 12 に、 立ち上げ試験時の圧力のトレンドを示す(1 台イオンポン プの電流測定が不調であったため、トレンドでは8台分を プロットした)。また、活性化後のガスは、主に水素と水に なっていることが残留ガス分析計からわかった。

この試験で、イオンポンプで測っている圧力は 1×10-7 Pa以下を実現した。

6. まとめ

SuperKEKB 陽電子 DR の建設が現在進行中である。 今回我々は、DR の真空制御システムを構築するために 2 セルのビームダクトを使って予備試験等を行い、その 経験を活かして安全なインターロックシステムや運用しや すいプログラムを実装した。また、構築した真空制御シス テムを用いて、DR 西アーク部で真空立ち上げ試験を行 い、成功した。

今後、真空冷却水制御システムの開発などを行うと共に、2017 年冬の DR 運転開始を目指し DR 全体の真空 立ち上げを行う予定である。



Figure 12: Trends of measured pressures during the NEG activation test at DR arc section.

謝辞

本報告にあたり、KEKB の BT グループ、モニターグ ループ、RF グループの皆様には、多くの支援を頂きまし た。また、ユーサと秀和電気の皆様にも支えていただき ました。感謝いたします。

参考文献

 Y. Funakoshi *et al.*, "BEAM COMMISSIONING OF SuperKEKB", Proceedings of IPAC2016, Busan, Korea, May 8-13, 2016, p. 1019; http://accelconf.web.cern.ch/AccelConf/ipac2016/papers/tu Proceedings of the 14th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan August 1-3, 2017, Sapporo, Japan

PASJ2017 TUP120

oba01.pdf

- [2] P. Raimondi, "NEW DEVELOPMENTS IN SUPER B-FACTORIES" Proceedings of PAC07, Albuquerque, New Mexico, NMZAKI02, USA, 25-29 June, 2007, p.32; http://accelconf.web.cern.ch/AccelConf/p07/PAPERS/MOZ AKI02.PDF
- [3] Y. Ohnishi et al., "SuperKEKB ビーム光学系の設計", Proceedings of the 8th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan, TUPS020, Tsukuba, Japan, 1-3 Aug, 2011, p.880; http://www.pasj.jp/web_publish/pasj8/proceedings/poster/T UPS020.pdf
- [4] M. Kikuchi *et al.*, "DESIGN OF POSITRON DAMPING RING FOR SUPER-KEKB", Proceedings of IPAC'10, TUPEB0540, Kyoto, Japan, 23-28 May, 2010, p.1641; http://epaper.kek.jp/IPAC10/papers/tupeb054.pdf
- [5] K. Shibata *et al.*, "Vacuum system of positron damping ring for SuperKEKB", Journal of Vacuum Science & Technology A: 35, 03E106 (2017)
- [6] http://www.aps.anl.gov/epics/
- [7] N. Yoshifuji *et al.*, "SuperKEKB での真空制御ソフトウェア の現状", Proceedings of the 13th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan, TUP090, Chiba, Japan, 8-10 Aug, 2016.
- [8] T. Ishibashi *et al.*, "SuperKEKB 真空機器制御システムと 立ち上げ試験", J.VAC. Soc. Jpn., 58(2015) 126.
- [9] J. Odagiri *et al.*, "EPICS ON F3RP61 FOR SUPERKEKB ACCELERATOR CONTROL", Proceedings of PASJ'14, Aomori, Japan, 9-11 Aug, 2014.